

การศึกษาตัวไดโอดีล็คทริกชนิดเซรามิกสที่ใชทำตัวเก็บประจุไฟฟ้า



นายสุรินทร์ นาคะวิวัฒน์

ศูนย์วิทยพัทยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานพนธนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529

ISBN 974-566-999-7

013404

i 18069344 -

**A STUDY OF CERAMIC DIELECTRIC FOR MAKING A CAPACITOR**



**Mr. Surin Nakaviwat**

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement**

**for the Degree of Master of Engineering**

**Department of Electrical Engineering**

**Graduate School**

**Chulalongkorn University**

**1986**

**ISBN 974-566-999-7**

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาตัวโคอิเล็กทริกซนิคเซรามิกส์ที่ใช้ทำตัวเก็บประจุไฟฟ้า

โดย

นายสุรินทร์ นาคะวิวัฒน์

ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สำรวัย สังข์สะอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี ลอประยูร



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาค้นคว้าหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย พิศาลบุตร)

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนรักษาการในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประโมทย์ อุดมไวยยะ)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม)

.....กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สำรวัย สังข์สะอาด)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี ลอประยูร)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาตัวไดโอดีเล็กทรอนิกส์เซรามิกส์ที่ใช้ทำตัวเก็บประจุไฟฟ้า

ชื่อนิพนธ์

นายสุรินทร์ นาคะวิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สำรวย สังข์สะอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี ลอประยูร

ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

ปีการศึกษา

2528



บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้รายงานผลการศึกษา ค้นคว้าวิจัยหาส่วนประกอบตัวไดโอดีเล็กทรอนิกส์ของตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดเซรามิกส์ ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ดีดีสูง โดยทำการวิเคราะห์ไดโอดีเล็กทรอนิกส์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงดันสูงชนิดเซรามิกส์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น พบว่าส่วนประกอบไดโอดีเล็กทรอนิกส์ที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ดีดีสูง ได้แก่สารประกอบประเภทเฟอร์ไรต์เล็กทรอนิกส์ เช่น ดิคาเนียมไดออกไซด์ ( $TiO_2$ ) และแบเรียมดิคาเนต ( $Ba TiO_3$ ) ซึ่งได้ใช้เป็นส่วนผสมหลักของตัวไดโอดีเล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยนี้การทำตัวไดโอดีเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมเนื้อสาร กระบวนการทำแคลไซน์ กระบวนการอัดขึ้นรูป และกระบวนการเผา พบว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา เพื่อให้ได้เนื้อไดโอดีเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ คือ ดิคาเนียมไดออกไซด์ต้องเผาที่อุณหภูมิสูง  $1,500^\circ C - 1,600^\circ C$  และแบเรียมดิคาเนต ต้องเผาที่อุณหภูมิ  $1,350^\circ C - 1,400^\circ C$  ทำการทดสอบคุณสมบัติทั้งทางด้านไฟฟ้าและทางด้านกายภาพ

ศูนย์วิทยพัชกร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาตัวโคอิเล็กตริกเซรามิกส์ที่ใช้ทำเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ามี  
รองศาสตราจารย์ ดร. สářาววย สังข์สะอาด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรม-  
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างยิ่งที่อาจารย์  
ได้ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ ทั้งทางด้านวิชาการและการทดลอง และช่วยเหลือแก้ไข  
ตรวจทานวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัสศรี รบประยูร  
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้กรุณาเป็นอาจารย์-  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เกี่ยวกับงานเซรามิกส์ยุคใหม่ ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาในการ  
วิเคราะห์และทำตัวโคอิเล็กตริก อนุเคราะห์ให้ความสะดวกในการใช้ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์  
ในการทำเนื้อสารโคอิเล็กตริกเซรามิกส์ และการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ผู้วิจัยขอขอบคุณ  
ต่อภาควิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความ  
ช่วยเหลือในการเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ หาส่วนประกอบของตัวโคอิเล็กตริก และผู้วิจัย  
ใคร่ขอขอบคุณต่อภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาเขตเทเวศร์  
ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องอัดระบบไฮดรอลิก ในการขึ้นรูปและการทดสอบสเปกซิเมน  
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องทดลองไฟฟ้าแรงสูง เจ้าหน้าที่ห้องทดลองงานเซรามิกส์ และ  
เจ้าหน้าที่ห้องทดลองเคมีวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และ  
ความสะดวกในการใช้เครื่องมือ และห้องทดลองเพื่อการทำวิจัย ห้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ  
ต่อหน่วยปฏิบัติการวิจัยไฟฟ้าแรงสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้หุ้  
อุทหนุนสำหรับงานวิจัยนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## สารบัญ

จ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ผ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญตาราง.....	ณ
สารบัญรูปภาพ.....	ญ
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ที่มาของปัญหา.....	1
1.2 เชรามิกส์ทั่วไป.....	1
1.2.1 ชนิดต่าง ๆ ของเชรามิกส์.....	2
1.2.2 ฉนวนเชรามิกส์.....	4
1.3 วัตถุประสงค์และขอบข่ายของงานวิจัย.....	5
2 ไคอิเล็กทริกเชรามิกส์.....	7.6
2.1 คุณสมบัติของไคอิเล็กทริก.....	6
2.1.1 ความต้านทานของไคอิเล็กทริก.....	6
2.1.2 เพอร์มิททิวิตีของไคอิเล็กทริก.....	7
2.1.3 แฟกเตอร์พลังงานสูญเสียในไคอิเล็กทริก..	7
2.1.4 ความคงทนต่อแรงดันของไคอิเล็กทริก....	10
2.2 กลไกการเกิดการโพลาไรเซชันในसानไคอิเล็กทริก.....	10
2.3 คุณสมบัติของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก.....	14
2.3.1 ทิศานะตเชรามิกส์.....	15
2.3.2 แบบเรียบทิศทาง.....	16
2.4 กระบวนการทั่วไปในการผลิตสารไคอิเล็กทริก เชรามิกส์.....	32



## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3 การทำตัวโคอิเล็กทริกเซรามิกส์.....	36
3.1 การวิเคราะห์ตัวอย่างโคอิเล็กทริกจากต่างประเทศ.	36
3.2 การเลือกส่วนผสมของโคอิเล็กทริกเซรามิกส์.....	37
3.3 การเตรียมเนื้อสารโคอิเล็กทริกเซรามิกส์.....	43
3.4 การทำปรีซีหรือแคลไซน์นิ่ง.....	56
3.5 กรรมวิธีการอัดขึ้นรูปสเปคซิเมน.....	59
3.6 การเผาโคอิเล็กทริกเซรามิกส์.....	67
4 การทดสอบตัวโคอิเล็กทริกเซรามิกส์ที่ทำขึ้น.....	71
4.1 การทดสอบส่วนผสมของเนื้อโคอิเล็กทริก.....	71
4.2 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ.....	71
4.3 การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า.....	79
4.3.1 การทดสอบค่าเปอร์มิททิวิตี้.....	79
4.3.2 การทดสอบหาค่าแฟกเตอร์พลังงานสูญเสีย.	82
4.3.3 การทดสอบความทนต่อแรงดันไฟฟ้าของ โคอิเล็กทริก.....	82
5 ผลการทดสอบตัวโคอิเล็กทริกเซรามิกส์และการวิเคราะห์ผล	86
5.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของตัวโคอิเล็กทริก	86
5.1.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติการหดตัว.....	86
5.1.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติความหนาแน่น.....	86
5.1.3 ผลการทดสอบคุณสมบัติความพรุนตัว.....	87
5.1.4 ผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้ำ.....	87
5.1.5 ผลการตรวจเฟส.....	95
5.1.6 ผลการตรวจโครงสร้างตัวโคอิเล็กทริกจาก ต่างประเทศ.....	100



## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.1.7 ผลการตรวจโครงสร้างของตัวโคอีเล็กทริก ที่ทำขึ้น.....	100
5.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของตัวโคอีเล็กทริก.....	107
6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	110
เอกสารอ้างอิง.....	112
ภาคผนวก.....	115
ประวัติผู้เขียน.....	125



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

2.1	คุณสมบัติของสารคิตาเนตเซรามิกส์.....	18
2.2	ค่าเปอร์เซ็นต์ปริมาตรของสารผสมคิตาเนตในช่วงความถี่ 60 เฮิรตซ์ ถึง 1,000 กิโลเฮิรตซ์.....	21
3.1	แสดงน้ำหนักของตัวอย่างโคอีเล็กทริกเซรามิกส์แบบแผ่นแบนกลม.....	41
3.2	ปริมาณวัตถุดิบทำเนื้อสารโคอีเล็กทริก.....	42
3.3	ตารางแสดงปริมาณวัตถุดิบที่บรรจุต่อหม้ออบ.....	49
5.1	คุณสมบัติทางกายภาพของคิตาเนียมโคอีออกไซด์และแบเรียมคิตาเนตที่อุณหภูมิต่าง ๆ.....	89
5.2	การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของคิตาเนตเซรามิกส์..	90
5.3	การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแบเรียมคิตาเนต...	91
5.4	แสดงการตรวจเฟสของวัตถุ.....	96
5.5	ผลการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า.....	109

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญรูปภาพ

รูปที่

หน้า

2.1	แสดงเวกเตอร์ไออะแกรม แรงดันและกระแสของ ตัวไออิเล็กทรอนิกส์.....	8
2.2	วงจรสมมูลย์ของไออิเล็กทรอนิกส์.....	9
2.3	แสดงการเกิดอิเล็กทรอนิกส์โพลาริเซชัน.....	11
2.4	แสดงการเกิดไอออนิกส์โพลาริเซชัน.....	11
2.5	แสดงการเกิดออเรียนเตชันโพลาริเซชัน.....	12
2.6	แสดงการเกิดโพลาริเซชันแบบประจุค้าง.....	12
2.7	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโพลาริเซชันกับ ความถี่.....	13
2.8	แสดงอะตอมของสารเฟอร์โรอิเล็กทริก อยู่ในสภาวะ เฟอร์โรอิเล็กทริกสเตท.....	14
2.9	กราฟแสดงผลของอุณหภูมิที่มีต่อค่าเปอร์มิตติวิตีของสาร แบเรียมทิตาเนต.....	17
2.10	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถักคั้นของสาร แบเรียมทิตาเนตเซรามิกส์.....	19
2.11	กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์มิตติวิตีของสาร แบเรียมทิตาเนต หลังจากปลดปล่อยแรงอัดคั้น.....	20
2.12	ผลของความถี่ที่มีต่อค่าเปอร์มิตติวิตี.....	21
2.13	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแฟกเตอร์ความสูญเสียในตัว ไออิเล็กทรอนิกส์กับค่าความถี่.....	22
2.14	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าแฟกเตอร์ความสูญเสียใน ตัวไออิเล็กทรอนิกส์แบเรียมทิตาเนตกับค่าความถี่.....	23
2.15	แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์มิตติวิตีของสารแบเรียม ทิตาเนต 69 % สตรอนเทียมทิตาเนต 31 % ในเทอม ของความเครียดสนามไฟฟ้า.....	24

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า

หน้า

2.16	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาตรแบบเรียมิตาเนต ต่ออุณหภูมิคูร์ของสารแบบเรียมสตรอนเทียมิตาเนต.....	25
2.17	แสดงโครงสร้างของผลึกเพอริออสเฟอไรต์ของสารแบบเรียม ิตาเนต.....	26
2.18	แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์ริคิตวิตี ต่อค่าอุณหภูมิของ สารแบบเรียมิตาเนต.....	27
2.19	แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอะตอมสาร เซรามิกส์ขณะทำการเผา.....	35
3.1	แผ่นสเปกซิเมนไดอิเล็กตริกสำหรับทดสอบหาค่าสมบัติทาง ไฟฟ้า.....	40
3.2	แสดงการชั่งน้ำหนักสารวัตถุดิบ.....	43
3.3	a,b) วัตถุดิบที่ใช้ทำสเปกซิเมนไดอิเล็กตริก.....	44
3.4	a,b) เครื่องบดแบบบดเปียก.....	46
3.5	แสดงลูกบดที่ใช้ในหม้อบด.....	47
3.6	แสดงการกรองน้ำสลิบโดยตะแกรงกรอง.....	50
3.7	แสดงการกรองสารโลหะเหลือออกจากน้ำสลิบ.....	52
3.8	แสดงการตกตะกอนน้ำสลิบ.....	53
3.9	แสดงกรรมวิธีการกำจัดน้ำออกจากเนื้อวัตถุดิบที่บดแล้ว..	53
3.10	แสดงการอบน้ำสลิบในเตาอบไฟฟ้า.....	54
3.11	a,b) เนื้อไดอิเล็กตริกหลังอบแห้ง.....	55
3.12	แสดงการบดเนื้อสารไดอิเล็กตริกหลังจากอบแห้ง.....	56
3.13	แสดงการทำแคลไซน์นิ่งเนื้อไดอิเล็กตริก.....	58
3.14	แผ่นเนื้อไดอิเล็กตริกหลังจากการทำแคลไซน์.....	59
3.15	แสดงการกรองขนาดผงเนื้อสารผ่าน 100 เมช.....	60
3.16	แสดงส่วนผสมของสารไบน์เดอร์.....	61

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
3.17 แสดงการผสมสารไบน์ เคอร์โดยมีการฉีกพันเป็นฝอย...	62
3.18 แสดงแบบอ๊คส์เปคซิเมน.....	64
3.19 แสดงเครื่องอ๊คไฮโครสเตติกส์ 100 คัน.....	65
3.20 แสดงการบรรจุผงเนื้อสารไดอิเล็กทริกเซรามิกส์ลงใน แบบอ๊ค.....	65
3.21 แสดงการอ๊คขึ้นรูปตัวไดอิเล็กทริกด้วยแรง 50 คัน....	66
3.22 แสดงการจ้ควางตัวอย่างสเปคซิเมนก่อนเข้าเตาอบเพื่อ อบแห้งก่อนการเผาจริง.....	66
3.23 แสดงการบรรจุตัวอย่างเข้าไปในเตาอบ.....	67
3.24 แสดงให้เห็นถึงเตาเผา และตู้ควบคุมอุณหภูมิเผา.....	68
3.25 แสดงไคอะแกรมการควบคุมอุณหภูมิการเผาไดอิเล็กทริก เซรามิกส์.....	70
4.1 แสดงเตาอบสเปคซิเมนที่จะทำการทดสอบ.....	75
4.2 การปล่อยให้เย็นตัวของสเปคซิเมน.....	75
4.3 เครื่องชั่งสเปคซิเมน.....	76
4.4 แสดงการค้มสเปคซิเมน.....	76
4.5, 4.6 แสดงการชั่งน้ำหนักสเปคซิเมนในน้ำ.....	77
4.7, 4.8 แสดงการชั่งน้ำหนักสเปคซิเมนขณะอ้มตัวด้วยน้ำ..	78
4.9 แสดงอุปกรณ์การรีด ริง คะแปซิเตอร์.....	80
4.10 วงจรเชียร์ริงบริดจ์.....	81
4.11 แสดงรูปแบบของการทดสอบความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ของตัวไดอิเล็กทริก.....	83
4.12 แสดงการอบไล่ความชื้นสเปคซิเมน 120 องศา ± 5 องศา นาน 2 ชั่วโมง.....	84

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า  
หน้า

4.13 แสดงวงจรการทดสอบความคงทนของโคอิเล็กทริก  
    ต่อแรงดันไฟฟ้า..... 85

5.1 แสดงผลการหาค่าของสเปกซีเมนของสารคิตาเนียม  
    โคอิออกไซด์และสารแบเรียมคิตาเนต ที่อุณหภูมิเผาต่าง ๆ 93

5.2 แสดงค่าความหนาแน่นของสเปกซีเมนของสารคิตาเนียม  
    โคอิออกไซด์ และสารแบเรียมคิตาเนต ที่อุณหภูมิเผาต่าง ๆ 93

5.3 แสดงผลความพรุนตัวของสเปกซีเมนของสารคิตาเนียม  
    โคอิออกไซด์ และแบเรียมคิตาเนต ที่อุณหภูมิเผาต่าง ๆ 94

5.4 แสดงผลการดูดซึมน้ำของสเปกซีเมนของสารคิตาเนียม  
    โคอิออกไซด์ และสารแบเรียมคิตาเนต ที่อุณหภูมิเผาต่าง ๆ 94

5.5 แสดงผลคิฟเฟรกโตแกรมของสารคิตาเนียมโคอิออกไซด์  
    ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เปรียบเทียบกับตัวอย่างจากประเทศ  
    สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น..... 97

5.6 แสดงผลคิฟเฟรกโตแกรมของสารแบเรียมคิตาเนตที่  
    อุณหภูมิเผาต่าง ๆ เปรียบเทียบกับตัวอย่างจากประเทศ  
    ฝรั่งเศส..... 98

5.7 แสดงจุลโครงสร้างของ  $TiO_2$  (Rutile) ตัวอย่าง  
    จากประเทศสหรัฐอเมริกา ถ่ายด้วยเครื่อง SEM  
    กำลังขยาย 3,500 เท่า..... 102

5.8 a,b) แสดงจุลโครงสร้างของ  $TiO_2$  (Rutile)  
    ตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น ถ่ายด้วยเครื่อง SEM กำลัง  
    ขยาย 3,500 เท่า..... 103

5.9 แสดงจุลโครงสร้างของ  $Sr(Fe)TiO_3$  ตัวอย่าง  
    จากประเทศฝรั่งเศส ถ่ายด้วยเครื่อง SEM  
    กำลังขยาย 3,500 เท่า..... 104

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า

5.10 a) แสดงจุลโครงสร้างของ $TiO_2$ เเผที่อุณหภูมิ 1,400 °C ถ่ายด้วยเครื่อง SEM กำลังขยาย 3,500 เท่า.....	105
b) แสดงจุลโครงสร้างของ $TiO_2$ เเผที่อุณหภูมิ 1,500 °C ถ่ายด้วยเครื่อง SEM กำลังขยาย 3,500 เท่า.....	105
5.11 a) แสดงจุลโครงสร้างของ $Ba TiO_3$ เเผที่อุณหภูมิ 1,250 °C ถ่ายด้วยเครื่อง SEM กำลังขยาย 3,500 เท่า.....	106
b) แสดงจุลโครงสร้างของ $Ba TiO_3$ เเผที่อุณหภูมิ 1,300 °C ถ่ายด้วยเครื่อง SEM กำลังขยาย 3,500 เท่า.....	106